

SILICON HIGH SPEED DIODES SILIZIUM SEHR SCHNELLE DIODEN

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten			Characteristic data ● Kenndaten										Case Gehäuse
	I_F	U_R	P	θ_a	U_F	at bei	I_F	I_R	at bei	U_R	t_{rr} from von	$I_F = 5 \text{ mA}$ on ● an	Q_s	
	mA	V	mW	°C	V		mA	μA		V	ns		pC	
KA206	75	50	200	25	< 1		10	5	> 50	4	$U_R = 6 \text{ V},$ $I_R = 0,5 \text{ mA}$	< 50	D7	
				25				< 0,05						20
				125				10						20
KA207	75	100	200	25	< 1		10	5	> 100	4	$U_R = 6 \text{ V},$ $I_R = 0,5 \text{ mA}$	< 50	D7	
				25				< 0,05						20
				125				10						20
KA206S	diodes KA206 selected on forward time ● Diode KA206, gemessene an Vorwärtserholungszeit													

SILICON HIGH SPEED HIGH CONDUCTANCE SWITCHING DIODES SILIZIUM-DIODEN MIT GROSSER LEITFÄHIGKEIT FÜR SCHNELLE SCHALTKEIRE

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten		Characteristic data ●		Kenndaten							Case Gehäuse	
	U_{RM}	I_{FM}	I_F min	at bei	U_F	I_R max	at bei	U_R	θ_a	t_{rr} max	at bei		I_F
	V	mA	mA		V	μA		V	°C	ns			mA
KA221	35	750	150 500	1 1,4	0,2 200	30 30		25 150	3			10 ... 400	D7
KA222	35	750	300 800	1 1,4	0,2 200	30 30		25 150	3			10 ... 400	D7
KA223	25	750	100 300	1 1,4	0,2 200	20 20		25 150	3			10 ... 400	D7
KA224	25	750	200 600	1 1,4	0,2 200	20 20		25 150	3			10 ... 400	D7
KA225	50	750	150 500	1 1,4	0,2 200	30 20		25 150	3			10 ... 400	D7

SILICON REFERENCE CIRCUITS SILIZIUM-REFERENZELEMENTE

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten		θ_a	U_Z	r_z	at bei	I_Z	s_z	at bei	I_Z	Case Gehäuse
	θ_a	θ_j									
	°C	°C	°C	V	Ω		mA	°C ⁻¹		mA	
KZZ45	-40 ... +100	125	25 25 25 25 0, +90	$10,8 \pm 0,5$ — — — —	— < 32 < 22 < 14 —	— 5 10 15 —	$5 \dots 10^1$ 5 10 15 —	— — — — —	— — — — —	$5 \dots 10 \pm 0,05^1)$	D22
KZZ46	-40 ... +100	125	25 25 25 0, +90	$10,8 \pm 0,5$ — — —	< 22 < 32 < 14 —	10 5 15 —	— — — —	— — — —	— — — —	$5 \dots 15$	D22
KZZ47	-40 ... +100	125	25 25 0, +70	$10,8 \pm 0,5$ — —	< 35 < 50 —	10 5 —	— — —	— — —	— — —	$5 \dots 10$	D22
KZZ82	0 ... +50	100	—	25	$7,5 - 9$	< 15	20 ... 100	< $10^{-4}^2)$	—	20 ... 100	D23
KZZ83	0 ... +50	100	—	25	$7,5 - 9$	< 15	20 ... 100	< $10^{-5}^2)$	—	20 ... 100	D23

Long-time stability ● Langzeitige Stabilität KZZ45, KZZ46: $\Delta U_Z \leq 5 \text{ mV/1000 h}$

¹⁾ Value of working current I_Z is quoted on plate of each device ●

Arbeitsstromwert I_Z ist auf Etikette jedes Bauelementes eingeführt.

²⁾ $\theta_a = 0 \dots 50 \text{ °C}$